ハイパスフィルタ · 330–2500 MHz

阻止域減衰量 · ≥40 dB (DC–240 MHz). 筐体寸法 (10 ± 0.2) × (7.5 ± 0.2) × (4 ± 0.3) mm.

RF 特性

項目	値
通過帯域	330–2500 MHz
通過帯域内挿入損失 [1]	≤2 dB
阻止域減衰量 [2]	≥40 dB
VSWR [1]	≤1.8:1

[1] 330–2500 MHz
[2] DC–240 MHz

設計定格 設計値

項目	値
許容電力	1 W
動作温度	−40...+70 °C
保存温度	−55...+85 °C

代表実測応答

周波数 (MHz)	S11 VSWR	S22 VSWR	S12 損失（dB）	S12 抑圧（dB）	S12 遅延（ns）
1	217.68	100.83	-82.37	-82.37	1.59
44	28602.01	558.14	-49.97	-49.97	1.21
87	684.92	731.69	-49.3	-49.3	0.91
129	146.06	255.74	-65.83	-65.83	-12.01
172	88.42	109.48	-47.32	-47.32	0.97
215	44.6	53.74	-59.7	-59.7	-12.24
258	14.1	17.61	-32.53	-32.53	-5.69
301	1.16	1.32	-3.08	-3.08	9.51
343	1.2	1.14	-1.23	-1.23	3.81
386	1.17	1.14	-0.79	-0.79	2.37
429	1.23	1.23	-0.64	-0.64	1.68
472	1.21	1.22	-0.5	-0.5	1.31
514	1.16	1.16	-0.46	-0.46	1.08

代表実測応答

周波数 (MHz)	S11 VSWR	S22 VSWR	S12 損失（dB）	S12 抑圧（dB）	S12 遅延（ns）
557	1.1	1.1	-0.39	-0.39	0.91
600	1.07	1.05	-0.31	-0.31	0.8

機械仕様

項目	値
実装方式	表面実装
品質グレード	産業用
筐体寸法	(10 ±0.2) × (7.5 ±0.2) × (4 ±0.3) mm
パッケージRF端子の内縁間隔	8.8 mm
基板RFランドの内縁間隔	8.6 mm
対向するクリアランスの内縁間隔	7.2 mm
短辺方向のクリアランス開口幅	2.6 mm
パッケージRF端子幅	1.0 mm
基板RFランドの短辺方向幅	1.2 mm
パッケージRF端子の切り欠き径	Ø0.6 mm

実装とプリント基板レイアウト

底面視では、入出力を入れ替えられる2つのRF端子が対向する短辺の中央にあります。底面の斜線部はGNDです。基板中央寄りの各RFランドに50 Ω給電線を配線し、グラウンド銅箔との間隔を確保してください。フットプリントの周囲と下にグラウンドビアを設けてください。 推奨基板レイアウトには、誘電体厚0.254 mmのRO4350Bを使用します。 独立したキャビティへの実装を推奨します。十分な接地を確保するため、可能な限りパッケージの側面、上面および底面をアセンブリの金属筐体に密着させてください。接地が不十分だと阻止域の抑圧が低下します。220 °Cでのリフローはんだ付けに対応します。清掃時はフィルタを洗浄液に浸さず、表面のみを清掃してください。

文書に関する注意

仕様は製品の更新に伴い改訂される場合があります。設計を確定する前に、現行の文書改訂版と製品固有の要件を LCRF に確認してください。供給構成は承認済みの見積書および注文書類で定義されます。